



## 多晶砷化镓的规格

	砷化镓半绝缘性, 无掺杂	砷化镓半导体性 p型和n型
直径		晶片: 从 0.5 英寸到 4.25 英寸 锭与合成物: 从 2 英寸到 6 英寸
厚度		晶片: 从 0.5 毫米到 40 毫米 锭与合成物: 从 50 毫米到 100 毫米
掺杂物	-	锌、硅、碲
载子浓度	-	n 型 $1 \times 10^{16} - 2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ p 型 $1 \times 10^{16} - 5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$
电阻率	$>1 \times 10^7 \Omega\text{cm}$	$>1 \times 10^{-3} \Omega\text{cm}$
霍尔迁移率	$> 1 \times 10^3 \text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$	n 型 $>1500 \text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$ ; p 型低
腐蚀坑密度 (EPD)	$<1 \times 10^4 \text{ cm}^{-2}$	液封直拉法 (LEC): $<7 \times 10^4 \text{ cm}^{-2}$ 垂直梯度凝固 (VGF): $<5 \times 10^3 \text{ cm}^{-2}$
表面处理		晶片: 切割/蚀刻 锭和合成物: 研磨/生长/切割
平面取向		US SEMI 或 EJ 标准
包装		标准/Fluoroware/Fluoroware N2 密封